



## ISDN Миниатюрные SMD модули интерфейса S<sub>0</sub>

### Характеристика

- отличные выходные характеристики обеспечивают соответствие формой импульсной волны ССИТТ.1.430 при использовании рекомендуемого спаривания ИС
- SMD модули спроектированы для совместимого размещения
- отличный и постоянный баланс между обмотками
- модульное исполнение максимизирует эффективность затухания и свойства передачи
- рабочая температура: 0 до 85 °C



### Электрическая характеристика при 25 °C

Коэффициент трансформации: **Жирно** = обмотка на стороне ИС

**Миниатюрные микросхемные SMD модули соответствуют основному уровню изоляции EN60950, UL1950 и UL1459**

Part Number	L <sub>p</sub> (mH Min)	Turns Ratio	L <sub>L</sub> (μH Max)	C <sub>c</sub> (pF Max)	R <sub>CU</sub> P (Ohms)	R <sub>CU</sub> S (Ohms)	V <sub>p</sub> (Vrms)	Schematic
<b>Трансформаторные модули без дросселя</b>								
MUJ-100A-000	25	1:1:1:1	5	50	2.1	2.1	1500	A
MUJ-103A-000	25	1:1:2:2	5	50	2.8	6.1	1500	A
MUJ-105A-000	25	1:1:2.5:2.5	5	50	3.3	9.8	1500	A
<b>Трансформаторные модули с дросселем</b>								
MUJ-100A or B-XXX	25	1:1:1:1	5	50	2.7	3.3	1500	A or B
MUJ-103A or B-XXX	25	1:1:2:2	5	50	3.7	8.4	1500	A or B
MUJ-105A or B-XXX	25	1:1:2.5:2.5	5	50	5.2	10.5	1500	A or B
<b>Синфазные дроссели</b>								
Basic P/N + Suffix	L <sub>N</sub> (μH)	R <sub>CU</sub> (Ohms)	Basic P/N + Suffix	R <sub>CU</sub> (Ohms)	Basic P/N + Suffix	R <sub>CU</sub> (Ohms)		
MUJ-100A or B-500	50	0.4	MUJ-103A or B-500	0.5	MUJ-105A or B-500	0.7		
MUJ-100A or B-101	100	0.5	MUJ-103A or B-101	0.6	MUJ-105A or B-101	0.9		
MUJ-100A or B-501	500	0.4	MUJ-103A or B-501	0.6	MUJ-105A or B-501	0.8		
MUJ-100A or B-502	5000	0.8	MUJ-103A or B-502	0.9	MUJ-105A or B-502	1.5		

### Условия измерения:

Полярность и коэффициент трансформации: +-1%

Индуктивность (L<sub>p</sub>): 25 мН минимум, обмотка на стороне линии последовательно при 10kHz, 100 мV

Индуктивность рассеяния: обмотка на стороне линии последовательно, обмотка на стороне ИС закорочена – измерено при 100 kHz, 100 мV

Ёмкость связи: обмотка на стороне ИС последовательно / обмотка на стороне линии последовательно при 10 kHz, 100 мV

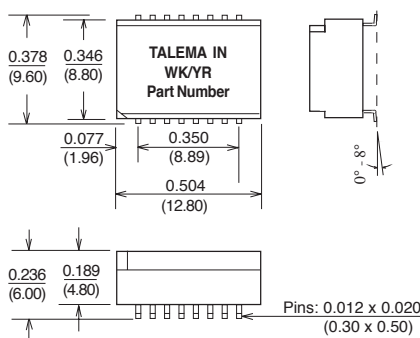
Индуктивность синфазного дросселя: 100 kHz, 20mV

Тест напряжения: 1.5 kV (2 сек) – обмотка на стороне линии последовательно / обмотка на стороне ИС последовательно

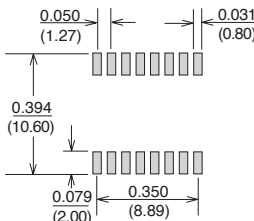
Параллельность с плоскостью: +-0,004 (0,10mm)

### Стандартная упаковка: Лента и катушка

#### MUJ Miniature Module

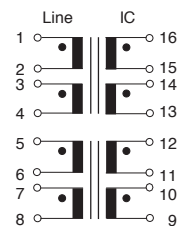


#### Предлагаемое размещение на подложке



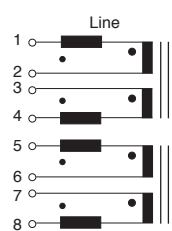
#### Схема без дросселей

**A**

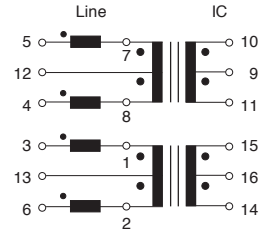


#### Схемы с дросселями

**A**



**B**



Поверхностная параллельность будет 0,004 (0,10)

Размеры: дюймы (мм)

Допуски: ±0,010 (0,25), если не указано иначе